

О ВЛИЯНИИ ВЫНУЖДЕННОГО КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ
НА ПРОНИКНОВЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ В НЕОДНОРОДНУЮ
МАГНИТОАКТИВНУЮ ПЛАЗМУ

И. И. Касымов ^{*)}, Р. Р. Рамазанов, А. Н. Стародуб

УДК 533.95

Исследовано вынужденное комбинационное рассеяние волны накачки плазмой в магнитном поле. Выявлены условия, в которых такая неустойчивость не влияет на энергоданс в квазистационарных магнитных ловушках.

Исследование закономерностей нелинейного рассеяния электромагнитных волн магнитоактивной плазмой представляет значительный интерес. Это связано как с необходимостью выявления условий, в которых такое рассеяние не приводит к существенным потерям энергии накачки, так и с возможностью использования рассеянного излучения для диагностики нелинейных плазменных явлений.

В связи с обсуждаемой возможностью нагрева плазмы в магнитных ловушках излучением в диапазоне нижнегибридных частот и выше $/1,2/$, обсудим закономерности нелинейного рассеяния мощного СВЧ излучения вследствие параметрического возбуждения вторичной электромагнитной и потенциальной нижнегибридной волн.

Пусть на плазму, находящуюся в сильном магнитном поле, таком, что циклотронная частота электронов Ω_e больше их ленгмюровской частоты ω_{Le} , падает обыкновенная электромагнитная волна

$$\vec{E}(x, t) = \vec{E}_0 \cos(\omega_0 t - k_0 x), \quad (1)$$

где вектор \vec{E}_0 параллелен магнитному полю \vec{B}_0 , вдоль которого

^{*)} Казахский государственный университет им. С. М. Кирова, г. Алма-Ата.

направлена ось z системы координат. В условиях $\Omega_e \gg \omega_0 \gg \omega \sim \omega_{Le}$, где ω - частота возбуждаемых нижнегибридных волн, следуя, например, /3/, получим следующее дисперсионное уравнение:

$$k^2 \varepsilon(\omega, \vec{k}) \Delta(\omega - \omega_0, \vec{k} - \vec{k}_0) = (1/4) k_z^4 \omega_{Le}^4 v_E^2 \omega^{-4} (\omega - \omega_0)^{-2} (1 - n_2^2) (1 - n_{2z}^2). \quad (2)$$

Здесь $\vec{n}_2 = (\vec{k} - \vec{k}_0) c / (\omega - \omega_0)$, $\varepsilon(\omega, \vec{k}) = 1 - \omega_{Le}^2 k_z^2 \omega^{-2} k^{-2} (1 - i \nu_{ei} / \omega)$, $\Delta(\omega - \omega_0, \vec{k} - \vec{k}_0) = (1 - n_2^2)^2 + i \omega_{Le}^2 \nu_{ei} (\omega - \omega_0)^{-3} [n_2^4 \cos^2 \theta_2 + n_2^2 (\sin^2 \theta_2 - 2) + 1]$,

θ_2 - угол между векторами \vec{n}_2 и \vec{B}_0 .

Согласно (2), граница рассматриваемой неустойчивости дается выражением

$$v_{E,b}^2 c^{-2} \equiv \varepsilon_{0,b}^2 (m \omega_0 c)^{-2} = 8 \omega_{Le} \nu_{ei} \gamma(k_z) [\omega_0 k^2 c^2 |\cos \theta|]^{-1}, \quad (3)$$

где $\cos \theta = \vec{k} \vec{B}_0 / k B_0$, $\gamma(k_z) = \frac{1}{2} \nu_{ei} + \sqrt{\frac{\pi}{8}} \frac{\omega^4}{|k_z|^3 v_{Te}^3} \exp \left[-\frac{\omega^2}{2 k_z^2 v_{Te}^2} \right]$

- декремент затухания нижнегибридной волны. Из выражения (3) следует, что на пороге неустойчивости возбуждаются возмущения, распространяющиеся вдоль магнитного поля, причем волновое число таких возмущений $k_m = (1/\sqrt{2} r_D) \ln^{-1/2} [(\omega_0/\nu_{ei}) \ln^{5/2} (\omega_0/\nu_{ei})]$.

Величина этого порога равна

$$v_{E,t}^2 / v_{Te}^2 = 8 \nu_{ei}^2 (\omega_0 \omega_{Le})^{-1} \ln(\omega_{Le} / \nu_{ei}). \quad (4)$$

Для анализа влияния неоднородности плотности на рассматриваемую неустойчивость воспользуемся уравнением эйконала, совпадающим с выражением (2), если в нем учесть зависимость плотности от координаты. Распадное взаимодействие в неоднородной плазме происходит в окрестности точки x_0 , в которой выполнено равенство $k_0(x_0) = k_{lx}(x_0) + k_{tx}(x_0) / 4$. (\vec{k}_l и \vec{k}_t - волновые векторы продольной и поперечной волн). Поэтому, разлагая плотность по степеням $x - x_0$, для величины $\Delta k = k_{lx}(x) - k_{lx}(x_0)$, согласно (2), получим

$$\Delta k = \frac{1}{4} \frac{k_1^2}{k_{1x}(x_0)} \frac{\Delta x}{L(x_0)} \pm \frac{1}{4} k_1^2(x_0) \frac{v_E}{c} \frac{\sqrt{1 - n_{2z}^2}}{\sqrt{k_{1x}(x_0)k_{tx}(x_0)}} \sqrt{\left| \frac{\Delta x}{\Delta x_t} \right|^2 - 1}, \quad (5)$$

где

$$\Delta x_t^2 = L^2(x_0) (v_E/c)^2 (1 - n_{2z}^2) k_{1x}(x_0) k_{tx}^{-1}(x_0), \quad \Delta x = x - x_0,$$

$$L(x_0) = \left[d \ln \omega_{Le}^2(x_0) / dx_0 \right]^{-1}, \quad k_1^2 = k_{1x}^2(x_0) + k_1^2, \quad k_1^2 = k_y^2 + k_z^2.$$

Выражение (5) справедливо в условиях

$$\sqrt{1 - k_1^2/k_0^2} \geq \left[\sqrt{1 - n_{2z}^2} k_0 v_E / 2\omega_0 \right]^{2/3} \equiv \varepsilon, \quad (\varepsilon \ll 1). \quad (6)$$

Согласно (5), в области $\Delta x^2 < \Delta x_t^2$ вблизи точки x_0 имеет место усиление параметрически связанных волн. Коэффициент усиления этих волн, прошедших область резонансного поглощения, в случае (7) равен

$$\mathfrak{K}_1(x_0) = \int_{-\Delta x_t}^{\Delta x_t} d(\Delta x) \operatorname{Im} \Delta k = \frac{\pi}{4} \frac{v_E^2}{c^2} k_0^2 L(x_0) \frac{1 - n_{2z}^2}{\sqrt{k_0^2 - k_1^2}} \left[1 + \sqrt{1 - \frac{k_1^2}{k_0^2}} \right]. \quad (7)$$

Из этого выражения следует, что по мере приближения значения k_1 к величине k_0 коэффициент усиления возрастает. При этом на границе области (6) этот коэффициент усиления достигает значения

$$\mathfrak{K}_2 = \frac{3^{3/2}}{2 \cdot 8^{2/3}} k_0 L(x_0) \left(\frac{v_E}{c} \right)^{4/3} (1 - n_{2z}^2)^{2/3},$$

которое остается справедливым и в области $\sqrt{k_0^2 - k_1^2} \leq \varepsilon k_0$.

Возбуждая по мере распространения в плазму вторичные волны, волна накачки передает им свою энергию и тем самым ослабляется. В изотропной плазме такое ослабление накачки благодаря ВКР было исследовано в работе /5/. Для описания влияния ВКР на проникновение волны накачки в магнитоактивную плазму мы можем использовать уравнение

$$\frac{d}{dx} (vW) = -\omega_0 T_e (16\pi^3 L(x_0))^{-1} \int d\vec{k}_1 \exp[2\kappa(\vec{k}_1)], \quad (8)$$

где $v = \partial\omega_0/\partial k_0 \approx c$, $W = E_0^2/4\pi$, которое отличается от соответствующего уравнения работы /5/ конкретным значением величины $\kappa(\vec{k}_1)$ и учетом спонтанного уровня, определяемого температурой электронов T_e .

Зависимость величины κ от \vec{k}_1 показывает, что основной вклад в интеграл в уравнении (8) дают волны с волновым вектором $\vec{k} = (\kappa k_0, k_0, 0)$, распространяющиеся поперек магнитного поля и практически поперек градиента неоднородности. Поэтому уравнение (8) для случая линейного профиля плотности, когда $L(x) = x$, можно привести к виду

$$dY/d\eta = -BY^{-5/3}Y^{-12/5} \exp(\kappa 2^{-2/3}\eta Y), \quad (9)$$

где

$$Y = (v_E/c)^{5/3}, \quad \eta = \omega_0 x/c, \quad B = (2^{5/9}/48\pi^{3/2})(T_e/mc^2)^{5/2}(\omega_0^3/n_c v_{Te}^3),$$

n_c — критическая плотность электронов плазмы.

Малость коэффициента B означает, что величина Y почти не изменяется, оставаясь равной своему значению Y_0 на границе плазмы, до тех пор, пока увеличение координаты η не компенсирует эту малость. Это произойдет при $x > x_1$, где

$$x_1 = (c/\omega_0)\eta_1 = (c/\omega_0 Y_0)(2^{2/3}/\pi)\ln(1/B) \approx \\ \approx \frac{2^{2/3}}{\pi} \frac{c}{\omega_0} \left(\frac{c}{v_E(0)}\right)^{5/3} \ln \left[\left(\frac{mc^2}{T_e}\right)^{5/2} \frac{n_c v_{Te}^3}{\omega_0^3} \right].$$

В области $x > x_1$ ВКР будет существенно влиять на проникновение волн. С логарифмической точностью убывание Y будет происходить по закону $Y \approx (2^{2/3}/\pi\eta)\ln(1/B)$, т.е.

$$E_0(x) \approx \sqrt{4\pi mc^2 n_c} (2^{2/5}/\pi^{3/5}) \left(\frac{c}{\omega_0 x}\right)^{3/5} \ln^{3/5} \left[\left(\frac{mc^2}{T_e}\right)^{5/2} \frac{n_c v_{Te}^3}{\omega_0^3} \right].$$

Условие $x_1 \geq L_0$, где L_0 — характерный размер плазмы, позволяет определить то критическое значение амплитуды волны накачки, начиная с которого ВКР может существенно сказываться на распространении этой волны. Такое значение равно

$$E_c(0) = \sqrt{4\pi n_0} c^2 \frac{2^{2/5}}{\pi^{3/5}} \left(\frac{c}{\omega_0 L_0} \right)^{3/5} \ln^{3/5} \left[\left(\frac{mc^2}{T_e} \right)^{5/2} \frac{n_0 v_{Te}^3}{\omega_0^3} \right]. \quad (10)$$

Если $E_0 < E_c(0)$, то влияние ВКР на интенсивность накачки не существенно.

Согласно (10), в случае воздействия на магнитоактивную плазму с размером ~ 1 м и плотностью $\sim 10^{14}$ см⁻³ излучения с длиной волны ~ 1 мм имеем $E_c \sim 100$ кВ/см. Столь большое значение $E_c(0)$ указывает на то, что в таком диапазоне частот СВЧ излучения ВКР не будет оказывать существенного влияния на энергетический баланс.

Поступила в редакцию
24 ноября 1980 г.

Л и т е р а т у р а

1. В. В. Аликаев, В. Е. Голант, К. Н. Степанов, Труды советско-американского семинара "Системный анализ и конструкции термоядерных электростанций", изд. НИИЭФА, Ленинград, 1974 г.
2. Р. Р. Рамазашвили, А. Н. Стародуб, Письма в ЖЭТФ, 29, 41 (1979); Физика плазмы, 6, 520 (1980).
3. В. В. Пустовалов, А. Б. Романов, Препринт ФИАН № 16, М., 1972 г.
4. А. Д. Пилля, 10-th International conference on Phenomena in ionized gases, rep. 4.3.8.1. Oxford, England. 1971.
5. Л. М. Горбунов, В. И. Домрин, Р. Р. Рамазашвили, ЖЭТФ, 70, 2161 (1976).